

Analog Power 600V N 通道耗尽型功率 MOSFET 采用先进沟槽技术与行业标准 SOT-23 封装的高压卓越性能!

美国加州圣荷西，2026 年 6 月 30 日 —Analog Power 今日正式启动 BSS126 的市场推广。这是一款高效率的 600V N 通道耗尽型功率 MOSFET，旨在以极具优势的紧凑外形提供卓越性能。此款全新器件采用广泛应用的 SOT-23 封装，具备 700Ω 的典型 $R_{DS(on)}$ 。通过导入先进的低 $R_{DS(on)}$ 沟槽技术 (Trench Technology) 并提供低热阻抗特性，它为设计工程师带来了针对高压与空间受限电子产品所优化的超高可靠性、快速开关解决方案。

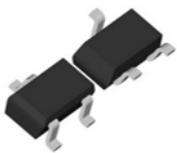
BSS126 让设计人员能够大幅提升电路板布局效率，同时维持优异的散热与电压管理。与传统体积较大的封装替代方案相比，此项技术突破极大地简化了高密度电路设计，在显著缩减电源布线与高压开关所需整体空间的同时，亦确保了出色的可靠性。

本元件的主要特色包括：

- 600V N 通道耗尽型功率 MOSFET：实现高效的高压电源调节与控制
- 低 $R_{DS(on)}$ 沟槽技术：最小化导通损耗，并大幅提升整体系统效率
- 低热阻抗：在极小的电路板空间内实现优异的散热性能
- 快速开关速度：非常适合高频高效率与精准控制的应用需求
- 坚固的半导体设计：确保在紧凑、高密度的环境中具备卓越的长期可靠性。

典型应用：

- 白光 LED 升压转换器：满足紧凑空间与高压开关控制的需求
- 汽车电子系统：满足对坚固、可靠且兼具空间效益的电子元件需求
- 工业 DC/DC 转换电路与薄型化电源模块
- 信号闸控与小信号开关电路：运行于高压线路之应用
- 空间受限的 IoT 传感器与嵌入式硬件应用



采用 SOT-23 封装的 BSS126 700Ω 、600V N 通道耗尽型 MOSFET 现已正式开放样品申请并投入量产。产品数据资料表请至下列网址下载：

<https://www.analogpowerinc.com/datasheet.php?part=AMPMH600UNE>

如需更多资讯，请造访：www.analogpowerinc.com。

关于 Analog Power：Analog Power 成立于 2002 年，总部位于美国加州圣何塞，是功率 MOSFET 的领先制造商。公司提供完整的 N 信道与 P 信道 MOSFET 产品线，电压范围覆盖 20V 至 1.5kV，并提供面向特定应用的 MOSFET，助力终端产品小型化并提升性能。依托与一流晶圆代工厂及封装测试外包伙伴的合作，Analog Power 在保持行业领先的质量与可靠性的同时，仍坚持灵活、高度以客户需求为导向的服务理念。



联系信息

Analog Power Inc

台北市内湖区洲子街 58 号 1 楼A7

邮政编码: 114064

<https://www.analogpowerinc.com/contactus.html>